ウ　31.8ギガヘルツ超37ギガヘルツ以下の合成出力周波数範囲において、550メガヘルツを超えるいずれかの周波数切換えの所要時間が500マイクロ秒未満のもの
エ　37ギガヘルツ超90ギガヘルツ以下の合成出力周波数範囲において、2.2ギガヘルツを超えるいずれかの周波数切換えの所要時間が100マイクロ秒未満のもの
オ　90ギガヘルツを超える合成出力周波数範囲において、周波数切換えの所要時間が１ミリ秒未満のもの
⑾　送受信モジュール、送受信用モノリシックマイクロ波集積回路、送信モジュール又は送信用モノリシックマイクロ波集積回路であって、動作周波数が2.7ギガヘルツを超えるもののうち、次のアからエまでの全てに該当するもの
ア　いずれかのチャネルにおいて、ワットで表したピーク飽和出力値が505.62をギガヘルツで表した最大動作周波数の２乗で除した値を超えるもの
イ　いずれかのチャネルにおいて、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が５パーセント以上のもの
ウ　平面のいずれかの辺の長さをセンチメートルで表した値が、送信又は送受信チャネル数と15の積をギガヘルツで表した最小動作周波数又はその動作帯域幅の下限が2.7ギガヘルツ以下に及ぶものについては2.7ギガヘルツで除した値以下のもの
エ　チャネル毎に電子的に位相シフトできるもの

50　弾性波若しくは音響光学効果を利用する信号処理装置であって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品
⑴　表面弾性波又は疑似表面弾性波を利用するものであって、次のいずれかに該当するもの
ア　搬送周波数が６ギガヘルツを超えるもの
イ　搬送周波数が１ギガヘルツ超６ギガヘルツ以下のものであって、次のいずれかに該当するもの
(ｱ)　サイドローブに対するメインローブの電力の比が65デシベルを超えるもの
(ｲ)　マイクロ秒で表した場合の最大遅延時間の数値にメガヘルツで表した場合の帯域幅の数値を乗じて得た数値が100を超えるもの
(ｳ)　帯域幅が250メガヘルツを超えるもの
(ｴ)　分散型遅延時間（周波数に応じた遅延時間の最大の値と最小の値との差をいう。この50において同じ。）が10マイクロ秒を超えるもの
ウ　搬送周波数が１ギガヘルツ以下のものであって、次のいずれかに該当するもの
(ｱ)　マイクロ秒で表した場合の最大遅延時間の数値にメガヘルツで表した場合の帯域幅の数値を乗じて得た数値が100を超えるもの
(ｲ)　分散型遅延時間が10マイクロ秒を超えるもの
(ｳ)　サイドローブに対するメインローブの電力の比が65デシベルを超えるものであって、帯域幅が100メガヘルツを超えるもの
⑵　バルク弾性波を利用するものであって、６ギガヘルツを超える周波数で信号の直接処理ができるもの
⑶　弾性波と光波の相互作用を利用したものであって、信号又は画像の直接処理ができるもの

51　超電導材料を用いた装置のうち、超電導材料を用いた部品を有する電子素子又は電子回路であって、使用する超電導材料の臨界温度より低い温度で使用することができるように設計し、かつ、次のいずれかに該当するもの
⑴　超電導ゲートを使用するデジタル回路の電流スイッチング機能を有するものであって、ゲート当たりの遅延時間にゲート当たりの電力消費を乗じて得た値が1,000億分の１ミリジュール未満のもの
⑵　周波数分離の機能を有するものであって、キュー値が10,000を超える共振回路を有するもの

52　電池であって、次のいずれかに該当するもの（シングルセルバッテリー又はバッテリーに組み込まれたものを除く。）
⑴　一次電池であって、20度の温度におけるエネルギー密度が550ワット時毎キログラムを超えるもの
⑵　二次電池であって、20度の温度におけるエネルギー密度が350ワット時毎キログラムを超えるもの

53　高電圧用のコンデンサであって、次のいずれかに該当するもの
⑴　反復サイクルが10ヘルツ未満のコンデンサであって、次のアからウまでの全てに該当するもの
ア　定格電圧が５キロボルト以上のもの
イ　エネルギー密度が250ジュール毎キログラム以上のもの
ウ　総エネルギーが25キロジュール以上のもの
⑵　反復サイクルが10ヘルツ以上のコンデンサであって、次のアからエまでの全てに該当するもの
ア　定格電圧が５キロボルト以上のもの
イ　エネルギー密度が50ジュール毎キログラム以上のもの
ウ　総エネルギーが100ジュール以上のもの
エ　10,000回以上の充電及び放電を繰り返すことができるように設計したもの

54　磁界を完全に形成させ、又は消失させるための所要時間が１秒未満となるように設計した超電導電磁石（ソレノイドコイル形のものを含む。）であって、次の⑴から⑶までの全てに該当するもの（医療用の磁気共鳴イメージング装置に用いるように設計したものを除く。）
⑴　減磁の際に最初の１秒間で放出するエネルギーが10キロジュールを超えるもの
⑵　コイルの内径が250ミリメートルを超えるもの
⑶　定格最大電流密度が300アンペア毎平方ミリメートルを超えるもの又は定格磁束密度が８テスラを超えるもの

55　太陽電池セル、セル連結保護ガラス集成品、太陽電池パネル又は太陽光アレーであって、宇宙用に設計したもののうち、エア・マス・ゼロで1,367ワット毎平方メートルの照射を受けたときの最小平均変換効率が、28度の動作温度において20パーセントを超えるもの

56　回転入力型のアブソリュートエンコーダであって、角度の変換誤差の絶対値が１秒以下のもの及び当該エンコーダ用に設計されたリング、ディスク又はスケール

57　パルス出力の切換えを行うサイリスターデバイス又はサイリスターモジュールであって、電気的に若しくは光学的に制御された切換え方法又は電子の放射を制御された切換え方法を用いたもののうち、次のいずれかに該当するもの（民生用の鉄道車両又は航空機に使用するように設計された装置に組み込まれたものを除く。）
⑴　最大立上がり電流が30,000アンペア毎マイクロ秒を超えるものであって、休止状態電圧が1,100ボルトを超えるもの
⑵　最大立上がり電流が2,000アンペア毎マイクロ秒を超えるものであって、次のア及びイに該当するもの
ア　休止状態電圧が3,000ボルト以上のもの
イ　最大電流が3,000アンペア以上のもの

58　電力の制御又は電気信号の整流を行う半導体素子又は半導体モジュールであって、次の⑴から⑶までの全てに該当するもの
⑴　最大動作接合部温度が215度を超えるように設計したもの
⑵　繰返しピーク休止状態電圧が300ボルトを超えるもの
⑶　継続電流が１アンペアを超えるもの

59　サンプリングオシロスコープであって、リアルタイムサンプリング手法を用いているもののうち、いずれかのチャネルの入力３デシベル帯域幅が60ギガヘルツ以上の場合において、そのチャネルのノイズが最小となる縦軸レンジにおけるノイズ電圧の２乗平均平方根がフルスケールの２パーセント未満のもの